

2SB750, 2SB750A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形ダーリントン
Si PNP Epitaxial Planar Darlington

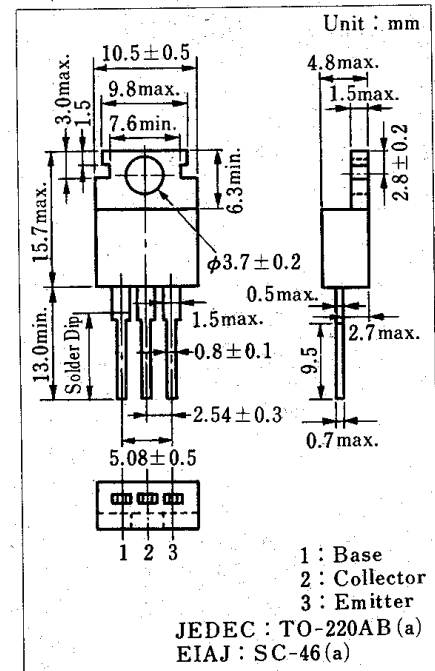
電力増幅用, スイッチング用 / Power Amplifier, Switching
2SD836, 2SD836A とコンプリメンタリ / Complementary Pair
with 2SD836, 2SD836A

■ 特 徴 / Features

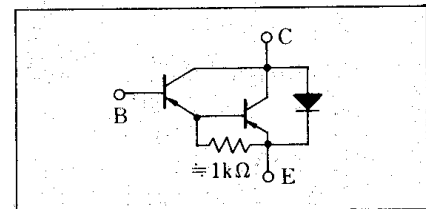
- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。 / High h_{FE}
- スイッチング速度が速い。 / High speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-60	V
		-80	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-60	V
		-80	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-4	A
コレクタ電流	I_C	-2	A
コレクタ損失 ($T_c = 25^\circ\text{C}$)	P_C	35	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$



内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ($T_c = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・シャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -60\text{V}, I_E = 0$			-1	mA
		$V_{CB} = -80\text{V}, I_E = 0$			-1	
コレクタ・シャ断電流	I_{CEO}	$V_{CB} = -30\text{V}, I_B = 0$			-2	mA
		$V_{CB} = -40\text{V}, I_B = 0$			-2	
エミッタ・シャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5\text{V}, I_C = 0$			-2	mA
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = -30\text{mA}, I_B = 0$	-60			V
		$I_C = -30\text{mA}, I_B = 0$	-80			V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -1\text{A}$	1000			
	h_{FE2}^*	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -2\text{A}$	1000		10000	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -4\text{V}, I_C = -2\text{A}$			-2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -2\text{A}, I_B = -8\text{mA}$			-2.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -2\text{A}, I_{B1} = -8\text{mA}, I_{B2} = 8\text{mA}$		0.2		μs
ターンオフ時間	t_{off}			2		μs

* h_{FE2} ランク分類 / h_{FE2} Classifications

Class	R	Q	P
h_{FE2}	1000 ~ 2500	2000 ~ 5000	4000 ~ 10000